Микроструктура и фазовый состав сплава дисилицидов железа и хрома

© Е.И. Суворова¹, Ф.Ю. Соломкин², Н.А. Архарова¹, Н.В. Шаренкова², Г.Н. Исаченко²

 Федеральный научно-исследовательский центр "Кристаллография и фотоника" Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова Российской академии наук, 119333 Москва, Россия
 Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, 194021 Санкт-Петербург, Россия

E-mail: f.solomkin@mail.ioffe.ru

Поступила в Редакцию 20 октября 2021 г. В окончательной редакции 25 октября 2021 г. Принята к публикации 25 октября 2021 г.

> Методами сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии, электронной дифракции и рентгеновской энергодисперсионной спектрометрии исследован фазовый состав, микроструктура и границы раздела фаз неупорядоченного сплава $CrSi_2$ —FeSi₂, полученного при спонтанной кристаллизации (до и после отжига). Неотожженные образцы имели в своем составе фазы $CrSi_2$ с гексагональной структурой $P6_422$ и FeSi₂ с тетрагональной структурой P4/mmm. В результате отжига произошло фазовое превращение тетрагонального FeSi₂ в ромбическую модификацию Cmca. Внутри областей ромбического FeSi₂ наблюдали выделения кубического моносилицида железа FeSi с пространственной группой P213, нанопреципитатов кремния и силицида кремния Cr_5Si_3 с тетрагональной структурой I4/mcm. Для фаз (ди)силицидов железа во всех образцах характерно наличие примесных межузельных атомов Cr до 2.0 at%. Структура фазы дисилицида хрома $CrSi_2$ до и после отжига не изменяется, концентрация примесных атомов железа и вычислены деформации из-за несоответствия кристаллических решеток.

> Ключевые слова: дисилицид хрома, дисилицид железа, граница раздела фаз, просвечивающая электронная микроскопия, рентгеновская энергодисперсионная спектрометрия.

DOI: 10.21883/FTP.2022.02.51960.33

1. Введение

Термоэлектрики на базе силицидов 3d переходных металлов представляют интерес для производства термоэлектрогенераторов и сенсорных устройств благодаря их химической и механической стойкости в окислительной среде при высоких температурах, их совместимости с кремниевой технологией, возможностью выбора среди них материалов *n*- и *p*-типа проводимости. Особый интерес при создании термоэлектрических преобразователей представляет синтез анизотропных многофазных материалов. Границы раздела фаз являются полноправной третьей фазой со своими структурой и свойствами и, в зависимости от соотношения размерных параметров микроструктуры, могут играть решающую роль в физических свойствах.

В работе [1] была показана принципиальная возможность создания механически прочного материала на базе среднетемпературных термоэлектриков $CrSi_2$ и $FeSi_2$ с высокой анизотропией термоэлектрических параметров. При направленной кристаллизации наблюдалось образование слоистой микроструктуры с периодическим повторением слоев $CrSi_2$ и $FeSi_2$. $CrSi_2$ — нетоксичный термоэлектрик с проводимостью *p*-типа и шириной запрещенной зоны 0.35 эВ обладает значительным фактором мощности с максимумом 45 мкВт/($K^2 \cdot cm$) при

T = 600 К, способен работать в агрессивных средах без специальной защиты. Текстурированный CrSi₂ может использоваться для создания анизотропных термоэлектрических генераторов, работающих в широком интервале температур (200–1000 К) [2]. Материал имеет широкую область гомогенности, поэтому термоэлектрические свойства образцов сильно зависят от условий синтеза, и стехиометрии [3].

Дисилицид железа FeSi₂, так же как и CrSi₂, является нетоксичным термоэлектрическим материалом, способным работать в агрессивных средах без специальной защиты. FeSi₂ образует кристаллы двух модификаций: высокотемпературной фазы α -FeSi₂ с тетрагональной структурой и металлическим типом проводимости, и низкотемпературной фазы β -FeSi₂ с ромбической структурой — полупроводник с шириной запрещенной зоны 0.85 эВ [4]. При отжиге α -FeSi₂ при температуре, соответствующей твердотельному фазовому переходу (1070–1170 K), происходит полиморфное превращение в фазу β -FeSi₂. Поэтапный отжиг α -FeSi₂ приводит к постепенному переходу от полуметалла к полупроводнику β -FeSi₂, без механического разрушения образцов [5].

В случае длительной направленной кристаллизации (метод Бриджмена) в температурной зоне, соответствующей твердотельному фазовому переходу, происходит отжиг изначально кристаллизовавшейся высокотемпера-



Рис. 1. СЭМ-изображение (обзорное) неупорядоченного сплава $CrSi_2$ — FeSi_x (*a*), распределение фаз (*b*) и соответствующее распределение элементов Si, Fe и Cr по данным ЭДС (*c*, *d*, *f*).

турной фазы с превращением ее в β -FeSi₂ [6]. Известно, что при длительной направленной кристаллизации за счет разных коэффициентов диффузии компонентов расплава, находящегося в температурном градиенте, происходит их разгонка по объему слитка. Поэтому в данной работе для выяснения фазового состава, дефектных состояний и состояния границ раздела фаз после синтеза использовалась спонтанная кристаллизация.

2. Материалы и методы исследования

Синтез образцов проводился в вакууме, прямым сплавлением мелкодисперсных компонент Cr, Fe и Si, взятых в соотношении, соответствующем стехиометрии CrFeSi₄, при T = 1723 К. После спонтанной кристаллизации образцы отжигали на воздухе при T = 1073 К в течение 72 ч.

Методами сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ), электронной дифракции (ЭД) и рентгеновской энергодисперсионной спектрометрии (ЭДС) исследованы химический и фазовый состав образцов до и после отжига в тонких частицах, полученных скалыванием массивных образцов. СЭМ (FEI Scios с ускоряющими напряжениями в интервале 5–15 кэВ) использовалась для получения обзорных изображений с распределением зерен различных фаз. ПЭМ, ЭДС и электронографическое исследование на микро- и наноуровне проводились в микроскопе Tecnai Osiris с ускоряющими напряжением 200 кВ. Обработка и интерпретация полученных данных проводилась с помощью программ Gatan Digital Micrograph (GATAN), JEMS [7], ESPRIT (Bruker). СЭМ-изображения и ЭДС предоставляют возможность оценить размеры и форму зерен, распределение элементов и фаз в образцах (рис. 1).

3. Результаты исследования микроструктуры

Материал отожженных и неотожженных образцов состоит из смеси случайно распределенных зерен фаз силицидов Cr и Fe. Светлые зерна на рис. 1 соответствуют фазам с большим средним атомным номером. Например, зерна (ди)силицида железа или комбинации силицида железа и примеси хрома будут всегда светлее по сравнению с зернами чистого CrSi₂ (средний атомный номер 36) или комбинация FeSi₂ и нановыделения Si (средний атомный номер 32).

Анализ ПЭМ-изображений и картин электронной дифракции показал, что CrSi₂ с гексагональной структурой $P6_422$ [8] образуется в синтезированных образцах до их отжига и не меняет своей структуры после отжига (рис. 2). Количественный ЭДС-анализ неотожженных образцов показал, что в зернах CrSi₂ может содержаться не более 0.7 ат% Fe, а в решетке тетрагональной фазы α -FeSi₂ до 2 ат% Cr. Тетрагональный α -FeSi₂ со структурой P4/mmn [9] после отжига превращается в фазу β -FeSi₂ с ромбической структурой Cmca [10]. Кроме то-



Рис. 2. ПЭМ-изображение (a) и картина электронной дифракции (b) с выделенными ячейками от CrSi₂ и FeSi₂ и opueнтационными соотношениями.

го, внутри зерен β -FeSi₂ наблюдали выделение нанокристаллов Cr₅Si₃ с тетрагональной решеткой и вытянутых нанопреципитатов Si, в то время как зерна CrSi₂ не содержат примеси железа или выделений кремния. Были выявлены тонкие слои FeSi с кубической структурой *P*213 [11], граничащие с CrSi₂. В таблице перечислены фазы силицидов в неупорядоченных сплавах CrSi₂—FeSi₂ до и после отжига.

Анализ картин электронной дифракции позволил определить несколько ориентационных соотношений для обоих типов образцов сплава. Обычной практикой является выражение ориентационных соотношений через плоскость и направление в одной фазе (преципитате), которые параллельны плоскости и направлению в другой фазе (матрице), для чего образец в электронном микроскопе наклоняется для получения дифракционной картины, в которой оси зоны (направления к плоскости картины) от обеих фаз совпадают. С помощью ориентационных соотношений можно оценить несоответствия между кристаллическими решетками и возможные деформации, а также степень когерентности межфазной границы. На рис. 2 представлено ПЭМ-изображение от неотожженного образца (рис. 2, a) с соответствующей электронной дифракцией (рис. 2, b), на которой присутствуют рефлексы от гексагонального CrSi₂ и тетрагонального FeSi₂. Между двумя фазами на экспериментальных электронограммах были выявлены следующие ориентационные соотношения:

- [142](225) FeSi₂ тетр // [1101] (3360)СrSi₂ гекс.
- [881](110) FeSi₂ тетр // [1120](2200) CrSi₂ гекс.

Несоответствие δ между решетками, рассчитанное по формуле

$$\delta = rac{2(d_{
m Fe} - d_{
m Cr})}{d_{
m Fe} + d_{
m Cr}},$$

где $d_{\rm Fe}$ и $d_{\rm Cr}$ — межплоскостные расстояния, от соответствующих плоскостей двух фаз силицидов Fe и Cr (d_{22-5} FeSi_{2 тетр} = 0.0696 нм, d_{-3-360} CrSi_{2 текс} = 0.0738 нм, d_{1-10} FeSi_{2 тетр} = 0.1906 нм, d_{2-200} CrSi_{2 текс} = 0.1107 нм) составляло ~ 6% для первого соотношения и 0.5% — для второго.

	До отжига		После отжига	
Фазы	Фаза	Пространственная группа	Фаза	Пространственная группа
Силицид Fe	FeSi ₂ тетр	P4/mmm	FeSi ₂ ромб FeSi куб	Cmca P213
Силицид Cr	CrSi ₂ гекс	P6 ₄ 22	СrSi ₂ гекс	P_{6_422}
Кремний	Не выявлен		Si куб	Fd-3m

Фазовый состав неупорядоченного сплава CrSi2-FeSi2 до и после отжига



Рис. 3. ПЭМ-изображение зерна β -FeSi₂ с нановыделениями Si (a), картина электронной дифракции (b) с рефлексами от β -FeSi₂ и Si, полученная от области, выделенной кругом на ПЭМ-изображении.

Для отожженных образцов установлены следующие ориентационные соотношения и несоответствия $\delta \approx 1\%$ между решетками CrSi₂ гекс и FeSi₂ ромб (d_{6-33-3} CrSi_{2 гекс} = 0.0697, d_{0-88} FeSi_{2 ромб} = 0.0691 нм):

Как уже было сказано выше, в образцах после отжига наблюдали выделения кубического моносилицида железа FeSi в зернах гексагонального $CrSi_2$ в виде тонких стержней шириной ~ 50 нм. Нанопреципитаты тетрагональной фазы Cr_5Si_3 [12] и кубического Si [13] (рис. 3) были выявлены в матричных зернах ромбического FeSi_2. Ориентационные соотношения между матричными зернами $CrSi_2$ и FeSi_2 и нановыделениями вторичных фаз после отжига представлены далее:

- [1230](0003) CrSi₂ гекс // [120](210)FeSi куб, $\delta \approx 8\%$.
- [112](153) FeSi₂ ромб // [379](223)Cr₅Si₃ тетр,

 $\delta \approx 0.4\%$.

• [311]($\overline{2}\overline{2}8$) FeSi₂ ромб // [123]($60\overline{2}$)Si куб, $\delta \approx 8\%$.

Для определения несоответствия между кристаллическими решетками фаз взяты следующие межплоскостные расстояния: d_{0003} CrSi_{2 гекс} = 0.2123 нм, d_{-210} FeSi_{ky6} = 0.2035 нм, d_{-1-53} FeSi_{2 ромб} = 0.1326 нм, d_{233} Cr₅Si_{3 тетр} = 0.1321 нм, d_{-2-28} FeSi_{2 ромб} = 0.0933, d_{60-2} Si_{ky6} = 0.0862 нм. Таким образом, все экспериментально наблюдаемые ориентационные соотношения свидетельствуют об образовании полукогерентных межфазных границ, при этом релаксация напряжений происходит с помощью дислокаций несоответствия. Очевидно, что возможны и другие ориентационные соотношения в разных направлениях с другими численными несоответствиями.

Деформации несоответствия параметров решеток различных фаз в материалах, а также несоответствие их коэффициентов теплового расширения порождают механические напряжения, которые снимаются образованием дефектов, например, трещин и каверн, которые выявляются на полированной поверхности как отожженных, так и неотожженных образцов (рис. 1, a). Деформация, вызванная различиями при тепловом расширении, может быть представлена в виде

$$\delta_{\text{therm}} = \frac{d_1^{RT}(\alpha_1 - \alpha_2)\Delta T}{d_2^{RT}(1 + \alpha_2\Delta T)},$$

где d_1^{RT} и d_2^{RT} — соответствующие межплоскостные расстояния в решетках двух фаз при комнатной температуре, ΔT — разница между температурой синтеза и комнатной температурой, α_1 и α_2 — коэффициенты теплового расширения фаз двух соседних зерен.

Значения коэффициентов линейного термического расширения (средние с учетом анизотропии) для β -FeSi₂ находятся в интервале $10.6 - 11.8 \cdot 10^{-6} \, \mathrm{K}^{-1}$ [14], CrSi₂ интервал значений а для составляет $10.6 - 14.2 \cdot 10^{-6} \,\mathrm{K}^{-1}$ [15] при температурах ОТ комнатной до 1173 К. Вклад в появление деформаций решетки твердого раствора благодаря разности коэффициентов теплового расширения составляет $\sim 0.5\%$, в то время как несоответствие параметров решетки FeSi2 и CrSi2 в неотожженных образцах доходит до 6%, что является основной причиной напряжений, при релаксации которых образуются дефекты. После отжига твердого раствора происходит выделение еще нескольких фаз с 8-процентным несоответствием между решетками матричных зерен и преципитатов, что также может приводить к напряжениям и в конечном итоге к появлению трещин в образцах.

4. Заключение

1. Данные, полученные при исследовании микроструктуры и состава неупорядоченного сплава с изначально заложенной при синтезе стехиометрией CrFeSi₄, свидетельствуют о стабильности фазы CrSi₂, которая после отжига не содержит ни примесей железа, ни выделений кремния.

2. Тетрагональный α -FeSi₂ после отжига превращается в β -FeSi₂ фазу с ромбической структурой, в которой наблюдается присутствие нанопреципитатов силицида Cr₅Si₃ с тетрагональной решеткой и вытянутых преципитатов Si, что в случае направленной кристаллизации сплава может быть технологическим фактором для управления физическими свойствами композита.

3. Между кристаллическими решетками фаз в различных кристаллографических направлениях установлены численные ориентационные несоответствия. Релаксация деформаций, вызванных несоответствиями между решетками, может проводить к образованию дислокаций на границах раздела с последующим растрескиванием материала.

Финансирование работы

Работа поддержана Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

Список литературы

- Ф.Ю. Соломкин, В.К. Зайцев, С.В. Новиков, А.Ю. Самунин, Д.А. Пшенай-Северин, Г.Н. Исаченко. ЖТФ, 84, 106 (2014).
- [2] M.I. Fedorov, V.K. Zaitsev. *Handbook of Thermoelectric*, ed. by D.M. Rowe (N.Y., CRC press., 2006) p. 31-2.
- [3] Ф.Ю. Соломкин, В.К. Зайцев, С.В. Новиков, Ю.А. Самунин, Г.Н. Исаченко. ЖТФ, **83** (2), 141 (2013).
- [4] U. Birkholz, E. Gross, U. Stohrer. *Handbook of Thermoelectrics*, ed. by D.M. Rowe (N.Y., CRC Press, 1995) p. 287.
- [5] Ф.Ю Соломкин, Д.А. Пшенай-Северин, А.Ю. Самунин, Г.Н. Исаченко. Тез. докл. Межгос. конф. "Термоэлектрики и их применения — 2014" (СПб., Россия, 2014) с. 407.
- [6] Ф.Ю. Соломкин, А.Ю. Самунин, Н.Ф. Картенко, А.С. Колосова. *IX Межгос. сем. "Термоэлектрики и их применения — 2004"* (СПб., Россия, 2004) с. 260.

- [7] P. Stadelmann. 2017. JEMS, описание программы можно найти на https://www.jems-swiss.ch/
- [8] K.Tanaka, K. Nawata, M. Koiwa, M. Yamaguchi, H. Inui. Mater. Res. Soc. Symp. Proc., 646, N 4.3.1 (2001).
- [9] B. Aronsson. Acta Chem. Scand., 14, 1414 (1960).
- [10] Y. Dusausoy, J. Protas. Acta Cryst. B, 27, 1209 (1971).
- [11] L. Vocadlo, K.S. Knight, G.D. Price, I.G. Wood. Phys. Chem. Miner, 29, 132 (2002).
- [12] C.H. Dauben, D.H. Templeton, C.E. Myers. J. Phys. Chem., 60, 443 (1956).
- [13] W.L. Bond, W. Kaiser. J. Phys. Chem. Sol., 16, 44 (1960).
- [14] M. Imai, Y. Isoda, H. Udono. Intermetallics, 67, 75 (2015).
- [15] Б.С. Рабинович, И.З. Радовский, П.В. Гельд. Порошковая металлургия, 7, 879 (1968).

Редактор А.Н. Смирнов

Microstructure and phase composition of an alloy of iron and chrome disilicides

E.I. Suvorova¹, F.Yu. Solomkin², N.A.Arkharova¹, N.V. Sharenkova², G.N. Isachenko²

 ¹ Shubnikov Institute of Crystallography, Federal Scientific Research Centre "Crystallography and Photonics", Russian Academy of Sciences, 19333 Moscow, Russia
 ² loffe Institute, 194021 St. Petersburg, Russia

Abstract The phase composition, microstructure, and interphase interfaces of the disordered CrSi2-FeSi2 solid solution obtained by spontaneous crystallization (before and after annealing) have been investigated by scanning, transmission electron microscopy, electron diffraction, and X-ray energy dispersive spectrometry. The as-grown samples contained the phases of CrSi2 with the $P6_422$ hexagonal structure and FeSi₂ with the P4/mmm tetragonal structure. Annealing of the samples led to the phase transformation of tetragonal FeSi2 into the orthorhombic modification Cmca. Precipitates of cubic iron monosilicide FeSi with space group P213, nano-precipitates of Si and silicon silicide Cr₅Si₃ with a tetragonal structure I4/mcm were observed inside the FeSi₂ grains. Impurities of interstitial Cr atoms with a concentration up to 2.0 at% are found in iron (di)silicides grains in all samples. The structure of the CrSi2 phase remains unchanged after annealing; the concentration of impurity iron atoms is about 0.7 at%. Orientation relationships between the crystal lattices of the phases are established and strains due to the mismatch of the crystal lattices are determined.

Публикация материалов Конференция завершена.